

### Публикации специалистов ведущей организации

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» по теме диссертационной работы Беляева К.Г. «Плазмонные эффекты в композитных металл-полупроводниковых структурах на основе соединений  $A_2B_6$  и  $A_3N$ »

1. А.В. Соломонов, С.А. Тарасов, Е.А. Менькович, И.А. Ламкин, С.Ю. Курин, А.А. Антипов, И.С. Бараш, А.Д. Роенков, Х. Хелава, Ю.Н. Макаров. Исследование характеристик ультрафиолетовых светодиодов на основе гетероструктур GaN/AlGaN, выращенных методом хлоридно-гидридной эпитаксии // Физика и техника полупроводников, 2014, том 48, вып. 2, с.259.
2. I Lamkin, S Tarasov. Ultraviolet photodiodes based on AlGaN solid solutions // Journal of Physics: Conference Series, 2013, vol. 461, p.012025.
3. Petrov P.K., Alford N.M., Kozyrev A., Gaidukov M., Altyinnikov A., Vasilevskiy A., Konoplev G., Tumarkin A., Gagarin A. Effect of ultraviolet radiation on slow-relaxation processes in ferroelectric capacitance structures // Journal of Applied Physics, 2010, V.107, №8, p.084102.
4. Аньчков Д.Г., Давыдов С.Ю. Влияние адсорбции на поверхностную подвижность носителей тока в полупроводниковой подложке // Физика твердого тела, 2011, т. 53, № 4, p. 820.
5. O. S. Komkov, D. D. Firsov, A. N. Semenov, B. Ya. Meltser, S. I. Troshkov, A. N. Pikhtin, S. V. Ivanov. Determination of the thickness and spectral dependence of the refractive index of  $Al_xIn_{1-x}Sb$  epitaxial layers from reflectance spectra // Semiconductors, 2013, Vol. 46, issue 2, p.292.
6. Барановский М.В., Глинский Г.Ф. Экспресс-диагностика светодиодов на основе гетероструктур InGaN/GaN фотоэлектрическим методом // Письма в журнал технической физики, 2013, т.39, № 10, с. 22.
7. S. Kurin, A. Antipov, I. Barash, A. Roenkov, A. Usikov, H. Helava, V. Ratnikov, N. Shmidt, A. Sakharov, S. Tarasov, E. Menkovich, I. Lamkin, B. Papchenko, Y. Makarov. Characterization of HVPE-grown UV LED heterostructures // Physica status solidi (C), 2014, №3, p.813.
8. О.В. Кучерова, В.И. Зубков, А.В. Соломонов, Д.В. Давыдов. Наблюдение локализованных центров с аномальным поведением в светоизлучающих гетероструктурах с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN // Физика и техника полупроводников, 2010 г., т. 44, вып.3, с. 352.
9. О.В. Кучерова, В.И. Зубков, Е.О. Цвелев, И.Н. Яковлев, А.В. Соломонов. Неразрушающая диагностика наногетероструктур с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN методом температурной спектроскопии адмиттанса // Заводская лаборатория, 2010 г., т. 76, № 3, с.24.

10. Барановский М.В., Глинский Г.Ф., Миронова М.С. Фотоэлектрический метод диагностики гетероструктур InGaN/GaN с множественными квантовыми ямами // Физика и техника полупроводников, 2013, т. 47, №1, с.60.
11. V. Zubkov, O. Kucheroва, D. Frolov, A. Zubkova. Electrochemical profiling of heterostructures with multiple quantum wells InGaN/GaN // Physica status solidi (C), 2013, v.10, № 3, p.342.
12. Афанасьев В.П., Вендик И.Б., Вендик О.Г., Кастро Р.А., Медведева Н.Ю., Одит М.А., Ситникова М.Ф., Петров А.А., Соколова И.М., Чигирев Д.А. Анализ диэлектрических спектров композитных герметизирующих покрытий в широком частотном диапазоне // Физика и химия стекла, 2012, Т. 38, №1, с. 86.
13. Монография: В.В. Лучинин, Ю.М. Таиров, А.В. Афанасьев, В.А. Ильин, А.В. Корляков, А.О. Лебедев, И.Е. Грачева, В.А. Мошников, О.А. Шилова, Г.Ф. Глинский, О.С. Комков, А.Н. Пихтин, С.А. Тарасов, В.И. Зубков, А.В. Соломонов, Н.П. Лазарева, Л.А. Марасина, А.С. Иванов, Н.В. Пермяков. Физика и технология микро- и наносистем, Изд-во «Русская коллекция», 2011, 240 с. ISBN 978-5-901440-72-8.